

F3

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **04078138 A**

(43) Date of publication of application: **12.03.92**

(51) Int. Cl.
H01L 21/31
H01L 21/205
H01L 21/302
H05B 3/62

(21) Application number: **02190699**

(22) Date of filing: **20.07.90**

(71) Applicant: **NGK INSULATORS LTD**

(72) Inventor:
SOMA TAKAO
USHIGOE RYUSUKE
NOBORI KAZUHIRO

**(54) SEMICONDUCTOR WAFER HEATING DEVICE
AND ITS MANUFACTURE**

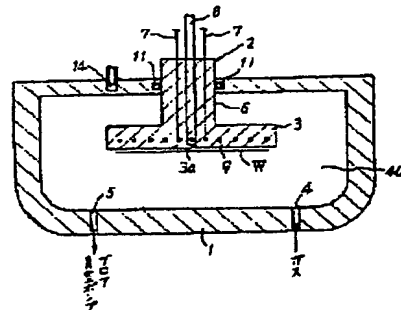
(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the corrosion of electrodes and contamination from the electrodes so as to simplify the title device by providing a projectionlike supporting section which is installed to the surface of a heater section other than the wafer heating surface and forms a gas tight seal against a container and the electrodes connected to a resistor heating body and led out to the outside of the container.

CONSTITUTION: This semiconductor wafer heating device 2 is constituted of a discoid heater section 3 and cylindrical supporting section 6, both of which are united with each other to one body in a T-shaped in cross section. The heater section 3 is constituted by burying resistor heating body 9 of tungsten, molybdenum, etc., in a ceramic body and electric power is supplied to its end section through electrodes 7 to heat a wafer heating surface 3a. The cylindrical supporting section 6 is united to the upper surface of the heater section 3 and the space between the outer peripheral surface of the supporting section 6 and a container 1 is gas tightly sealed with an O-ring 11. Then a thermocouple 8 and the two electrodes 7 are buried in the heater

section 3 and supporting section 6 and led out to the outside of the container 1 from the upper end face of the supporting section 6.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio



Best Available Copy

特公平6-28258

(24) (44) 公告日 平成6年(1994)4月13日

(51) Int. Cl. ⁵

識別記号

F I

H01L 21/31

E

21/205

21/302

B 9277-4M

21/324

D 8617-4M

H05B 3/62

7913-3K

請求項の数7 (全5頁)

(21) 出願番号 特願平2-190699

(22) 出願日 平成2年(1990)7月20日

(65) 公開番号 特開平4-78138

(43) 公開日 平成4年(1992)3月12日

(71) 出願人 999999999

日本碍子株式会社

愛知県名古屋市中区瑞穂区須田町2番56号

(72) 発明者 相馬 隆雄

愛知県西加茂郡三好町大字福谷字吉良戸36番地の1

(72) 発明者 牛越 隆介

愛知県半田市新宮町1丁目106番地 日本碍子新宮アパート206号

(72) 発明者 ▲しょう▼ 和宏

愛知県葉栗郡木曽川町大字黒田字北宿二ノ切66-1

(74) 代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外5名)

審査官 中西 一友

(54) 【発明の名称】 半導体ウエハー加熱装置及びその製造方法

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 抵抗発熱体が埋設され、容器内に設置され、ウエハー加熱面が設けられたセラミックス製のヒーター部と；

このヒーター部の前記ウエハー加熱面以外の面に設けられ、前記容器との間で気密性シールを形成する凸状支持部と；

前記抵抗発熱体へと接続され、前記容器の内部空間へと実質的に露出しないように前記容器外へと取り出された電極とを有する半導体ウエハー加熱装置。

【請求項2】 前記ヒーター部内へと熱電対の一端を埋設し、前記容器の内部空間へと前記熱電対が実質的に露出しないようにこの熱電対の他端を前記容器外へと取り出した、請求項1記載の半導体ウエハー加熱装置。

【請求項3】 前記凸状支持部がセラミックスからなる、

2

請求項1又は2項記載の半導体ウエハー加熱装置。

【請求項4】 前記凸状支持部が金属又は金属の化合物からなり、前記ヒーター部の前記ウエハー加熱面以外の面に接合されている、請求項1又は2項記載の半導体ウエハー加熱装置。

【請求項5】 前記ヒーター部と前記凸状支持部とを、一体成形体をホットアイソスタティックプレスにより一体焼結することで製造する、請求項3記載の半導体ウエハー加熱装置の製造方法。

10 【請求項6】 前記ヒーター部用成形体と、前記凸状支持部用成形体とをそれぞれ成形し、これらの各成形体を互いに接合して接合体を作製し、この接合体を焼結して前記ヒーター部と前記凸状支持部とを製造する、請求項3記載の半導体ウエハー加熱装置の製造方法。

【請求項7】 ヒーター部と凸状支持部とをそれぞれ焼結

により作製し、このヒーター部と凸状支持部とをガラス接合又は拡散接合によって接合して一体化する、請求項 3 記載の半導体ウエハー加熱装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

(産業上の利用分野)

本発明は、プラズマ CVD、減圧 CVD、プラズマエッチング、光エッチング装置等に使用される半導体ウエハー加熱装置に関するものである。

(従来の技術及びその問題点)

スーパークリーン状態を必要とする半導体製造用装置では、腐食性ガス、エッチング用ガス、クリーニング用ガスとして塩素系ガス、弗素系ガス等の腐食性ガスが使用されている。このため、ウエハーをこれらの腐食性ガスに接触させた状態で加熱するための加熱装置として、抵抗発熱体の表面をステンレススチール、インコネル等の金属により被覆した従来のヒーターを使用すると、これらのガスの曝露によって、塩化物、酸化物、弗化物、酸化物等の粒径数 μm の、好ましくないパーティクルが発生する。

そこで第 4 図に示されるように、デポジション用ガス等に曝露される容器 1 の外側に赤外線ランプ 30 を設置し、容器外壁に赤外線透過窓 31 を設け、グラファイト等の耐食性良好な材質からなる被加熱体 32 に赤外線を放射し、被加熱体 32 の上面に置かれたウエハーを加熱する、間接加熱方式のウエハー加熱装置が開発されている。ところがこの方式のものは、直接加熱式のものに比較して熱損失が大きいこと、温度上昇に時間がかかること、赤外線透過窓 31 への CVD 膜の付着により赤外線の透過が次第に妨げられ、赤外線透過窓 31 で熱吸収が生じて窓が過熱すること等の問題があった。

(発明に至る経過)

上記の問題を解決するため、本発明者等は、新たに円盤状の緻密質セラミックス内に抵抗発熱体を埋設し、このセラミックスヒーターをグラファイトの支持部に保持した加熱装置について検討した。その結果この加熱装置は、上述のような問題点を一掃した極めて優れた装置であることが判明したが、腐食性ガスを使用する半導体装置内では電極、熱電対のシールが必要であり、シール構造が煩雑となるという問題点がなお残されている。

(発明が解決しようとする課題)

本発明の課題は、従来の金属ヒーターのような汚染を防止でき、また間接加熱方式の場合のように熱効率の悪さや赤外線透過窓への膜付着のような問題を生じず、しかも電極の腐食や、電極間、電極ケース間の放電、漏電をも防止できるような半導体ウエハー加熱装置を提供することである。

(課題を解決するための手段)

本発明は、抵抗発熱体が埋設され、容器内に設置され、ウエハー加熱面が設けられたセラミックス製のヒーター部と；

このヒーター部の前記ウエハー加熱面以外の面に設けられ、前記容器との間で気密性シールを形成する凸状支持部と；

前記抵抗発熱体へと接続され、前記容器の内部空間へと実質的に露出しないように前記容器外へと取り出された電極とを有する半導体ウエハー加熱装置に係るものである。

また、本発明は、前記ヒーター部と前記凸状支持部とを、一体成形体をホットアイソスタティックプレスにより一体焼結することで上記の半導体ウエハー加熱装置を製造する方法に係るものである。

また、本発明は、ヒーター部用成形体と、凸状支持部用成形体とをそれぞれ成形し、これらの各成形体を互いに接合して接合体を作製し、この接合体を焼結してヒーターと凸状支持部とを製造する、上記の半導体ウエハー加熱装置を製造する方法に係るものである。

また、本発明は、ヒーター部と凸状支持部とをそれぞれ焼結により作製し、このヒーター部と凸状支持部とをガラス接合又は拡散結合によって接合して一体化する、前記の半導体ウエハー加熱装置の製造方法に係るものである。

(実施例)

第 1 図は、半導体製造用熱 CVD 装置に本実施例の加熱装置 2 を取り付けた状態を示す断面図である。

容器 1 の内部にはガス供給孔 4 から熱 CVD 用のガスが供給され、吸引孔 5 から真空ポンプにより内部に空気が排出される。加熱装置 2 は、円盤状ヒーター部 3 と円柱状支持部 6 とを一体化した断面 T 字形のものである。円盤状ヒーター部 3 は、緻密でガスタイトなセラミックスの内部にタングステン、モリブデン系等の抵抗発熱体 9 をスパイラル条に埋設してなり、その端部には電極 7 を介して電力が供給され、ウエハー加熱面 3a を例えば 1100℃ 程度にまで加熱することができる。現在ウエハー W は例えば 4～8 インチであるが、ウエハー加熱面 3a はこのウエハー W の全体を加熱しうるだけの大きさとする。円盤状ヒーター部 3 の上側には、上記したように円柱状支持部 6 が一体化され、円柱状支持部 6 の外周面と容器 1 との間が O リング 11 により気密シールされている。図中、14 は水冷ジャケットである。そして、熱電対 8 と二本の電極 7 とが円盤状ヒーター部 3、円柱状支持部 6 に埋設され、円柱状支持部 6 の上側端面から容器 1 外へと取り出される。

本実施例の加熱装置によれば、従来の金属ヒーターの場合のような汚染や、間接加熱方式の場合のような熱効率の悪化の問題を解決できる。

しかも、電極 7 が支持部 6 中に埋設され、容器内空間 40 内へと露出しないので、電極 7 の腐食、電極 7 からの汚染、さらには、真空中での電極間又は電極と容器 1 との間の放電、漏電のおそれがない。従って、電極 7 をシールする特別のシール構造は不要であり、また電極材料と

してタングステン以外の高融点金属を使用できる。

また、熱電対 8 も支持部 6 内へと埋設され、容器内空間 40 へと露出しないので、熱電対をシールする特別のシール構造を必要とせず、非常に有利である。即ち、本出願人の研究によれば、特に真空中の場合、熱電対の周囲のガス分子の挙動は、大気圧 ~ 1 torr の真空状態においては粘性流域にあるが、真空度が高まると分子流域に移行し、これに伴って熱電対の周囲における熱移動の態様が大幅に変化するため、正確な温度測定ができなくなることが判っている。また、粘性流域においても、圧力変動 10 が大きい場合は温度測定誤差が存在することが判っている。この点、本実施例では、熱電対 8 が容器内空間 40 へと露出することなく外部へと接続されているので、上記のような温度測定誤差の問題は生じない。

また、円柱状支持部 6 を容器 1 に対して気密にシールすることにより、ヒーター部 3 を支持するので、ヒーター部 3 を支持するための特別な支持部材を必要としない。従って、加熱装置全体の表面積を小さくでき、表面吸着ガスが少なく、高真空では表面吸着ガスを放出させる必要があることから、高真空を利用する半導体製造装置において有利である。 20

更に、本発明者の研究によれば、例えばグラファイト製のカバーで円盤状ヒーターの側面を支持すると、この側面から熱が逃げ、円盤状ヒーターの外縁部と内周部との間で均熱を図るのが難しかった。これに対し、本実施例では、側面方向への熱の逃げがないので、加熱面 3a の均熱化を図るのがより容易である。

円盤状ヒーター部 3 の材質としては、シリコンナイトライド、サイアロン、窒化アルミニウム等が好ましく、シリコンナイトライドやサイアロンが耐熱衝撃性の点で更に好ましい。円柱状支持部 6 の材質としては、後述する 30 一体焼結の関係からヒーター部 3 と同一材質とすると好ましいが、少なくとも緻密質セラミックスを使用すれば、汚染のおそれが少ないので便利である。

加熱装置 2 を製造するには、ヒーター部 3 と支持部 6 との形状となるようにセラミックス粉末を一体成形し、この成形体に予め電極 7 と熱電対 8 とを埋め込んでおき、ホットアイソスタティックプレスにより一体焼結する。容器 1 と支持部 6 との間のシールは、第 1 図に示すオーリングの他、拡散接合、摩擦圧接、表面にスパッタリングで金属薄膜を設けたうえでの摩擦圧接、ガラス接合、 40 メタルバックング等によることができる。

ウエハー加熱面 3a は平滑面とすることが好ましく、特にウエハー加熱面 3a にウエハー W が直接セットされる場合には、平面度を $500 \mu\text{m}$ 以下としてヒーター部 3 と接するウエハー W の裏面へのデポジション用ガスの侵入を防止する必要がある。

ヒーター部 3 の内部に埋設される抵抗発熱体 9 としては、高融点でありしかも Si , N , 等との密着性に優れたタングステン、モリブデン、白金等を使用することが適 50

当である。

第 2 図の加熱装置 12 においては、円柱状支持部の代りに円筒状支持部 16 を円盤状ヒーター部 3 と接合一体化し、円筒状支持部 16 と容器 1 との間を気密にシールした。そして、電極 7 及び熱電対 8 の一端を円盤状ヒーター部 3 中へと埋設し、それぞれ円筒状支持部 16 の筒内空間内へと取り出した。本実施例の加熱装置によって、第 1 図のものと同様の効果が得られる。

加熱装置 12 を製造するには、上記したホットアイソスタティックプレスを適用できる他、次の方法を好適に利用できる。

(1) ヒーター部 3 を常圧焼結又はホットプレス焼結で焼結し、その際、電極 7 と熱電対 8 とは予め成形体中に埋設しておく。円筒状支持部 16 については、予め射出成形又は押し出し成形、プレス成形、静水圧プレス成形し、常圧焼結して製造する。そしてこれらの各焼結体を気密にガラス接合する。

(2) ヒーター部用成形体と円筒状支持部用成形体とを個別に押出成形、射出成形、プレス成形、静水圧プレス成形等で成形し、 $1/100 \sim 10\text{mm}$ の寸法公差を持たせた嵌メ合いにより常圧焼結するか、あるいは、ヒーター部用成形体に円筒状支持部用成形体を充分な圧力で押しつけ、加圧焼結する。

(3) ヒーター部 3 を上記 (1) のように焼結し、円筒状支持部 16 を金属又は金属の化合物で成形し、両者をガラス接合によって気密に接合する。

円筒状支持部 16 の材質としては、上記のセラミックスの他、金属、金属の化合物を使用することもできる。この材質として緻密質セラミックスを使用すると、汚染のおそれが少ないので有利である。また、金属としては、半導体ウエハー W の汚染につながらないものがよく、具体的には加熱ヒーター部 3 に近い部分は、高温で使用可能なタングステン、モリブデン、タンタル、チタンが好ましく、さらにオーリング 11 部の低温部にはステンレス、アルミニウム等が好ましい。

第 3 図は更に他の実施例を示す断面図である。

この例では、円盤状ヒーター部 3 の周縁部に、断面 L 字形の支持部 26 を設け、この支持部 26 の水平方向に伸びる延在部 27 と容器 1 との間で気密シールを行っている。

(1) 第 1 図における加熱装置 2 の円盤状ヒーター部 3 と円柱状支持部 6 の一体部、第 2 図の加熱装置 12 におけるヒーター部 3 と円筒状支持部 16 の接合部は、いずれの場合も容器 1 に固定する際、支持部を保持するため、一体部、接合部に応力集中しやすく、破壊の危険性が生じるが、第 3 図に示す加熱装置 22 では円盤状ヒーター部 3 の周縁部に断面 L 字形の支持部 26 を有するため、保持する面積が広く応力が分散し、一体部、接合部での破壊が生じにくい特徴がある。

(2) 熱 CVD 等では、デポジション後にウエハー W 外の面に CVD 膜が附着し、これをプラズマによりクリーニ

ングする場合に、ヒーター凹面のA部にプラズマ用電極を配置することができるため、プラズマ電極が容器1内のガスの雰囲気さらされない特徴がある。

(3) ヒーター凹面のA部に冷却構造を取りつけることにより、冷却時の応答性を良好とすることができる。

(4) ヒーター凹面のA部に、ヒーター部3のウエハーWチャック面の温度分布に合わせて断熱、冷却手段を設け、ウエハーWチャック面の温度分布をコントロールできる。

電極7の腐食及び半導体ウエハーWの汚染においては、上記加熱装置2及び12と同様に良好な結果が得られる。この加熱装置22を製造するには、ホットアイソスタティックプレス法の他、上記(1)～(3)の方法をいずれをも利用できる。

ウエハー加熱面の均熱性は、加熱装置2及び12の場合、加熱面中心の温度よりも加熱面周縁部温度の方が低いいため、支持部6及び16の径を変化させることにより伝熱面積を制御し加熱面の均一性を得ることができる。

加熱装置22では円盤状ヒーター部3の周縁部に断面L字形の支持部26を有するため、支持部26の伝熱により加熱面周縁部の放熱量が大きい。このため第3図の実施例では、ヒーター部3の外周部で発熱量を大きくした発熱体を埋設した。

なお、上記の例において、熱電対以外の温度測定装置、例えば放射温度計を使用できる。また、上記の例ではウエハー加熱面を下向きにし、ウエハーを図示しないピンにより下から支持して処理を行ったが、ウエハー加熱面を上向きにしてもよい。

上記の例では凸状支持部は、容器の天井側の壁面との間でシールされていたが、凸状支持部の取り付け位置はこれには限定されず、容器の下側壁面又は側壁に取り付けることもできる。

また、上記の例では、凸状支持部を、ウエハー加熱面の反対側の背面に設けていたが、円盤状ヒーター部の側面に設けることもできる。なお、ヒーター部の形状は、円形ウエハーを均等に加熱するためには円盤状とするのが好ましいが、他の形状、例えば四角盤状、六角盤状等としてもよい。

本発明は、プラズマエッチング装置、光エッチング装置等に対しても適用可能である。

(発明の効果)

本発明に係る半導体ウエハー加熱装置及びその製造方法によれば、ヒーター部が容器内に設置されてウエハーを直接加熱するために熱効率が高く、ヒーター部が、抵抗発熱体の埋設されたセラミックスからなるので、金属ヒーターの場合のように汚染を生じない。

そして、抵抗発熱体へと接続された電極が容器の内部空間へと実質的に露出しないので、電極の腐食、電極からの汚染のおそれがない。従って、電極をシールするための特別なシール構造は不要であり、電極材料としてタングステン以外の高融点金属を使用することもできる。

更に、凸状支持部と容器との間で気密性シールを形成するので、ヒーター部を支持するための特別な支持部材を必要としない。従って、加熱装置全体を簡素化でき、表面積を小さくできる。このことから表面吸着ガスを少なくでき、高真空を利用する半導体製造装置において有利である。

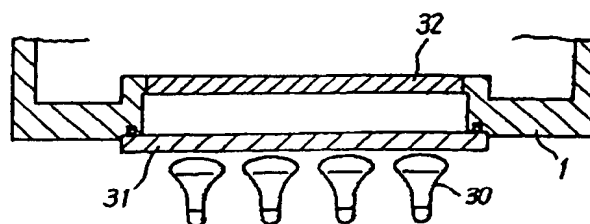
【図面の簡単な説明】

第1図、第2図、第3図はそれぞれ本発明の実施例に係る半導体ウエハー加熱装置を容器に取り付けた状態を示す概略断面図、

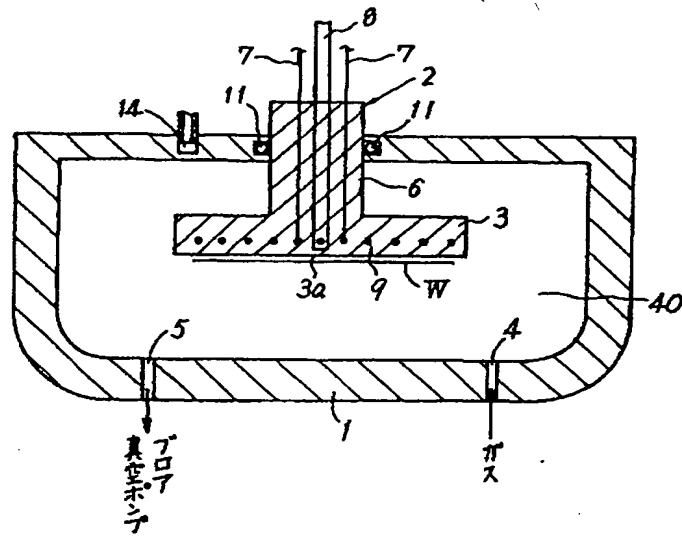
第4図は従来の間接加熱方式による加熱装置を示す要部断面図である。

- 1……容器
- 2, 12, 22 ……半導体ウエハー加熱装置
- 3……セラミックス製の円盤状ヒーター部
- 6……円柱状支持部
- 7……電極
- 8……熱電対
- 9……抵抗発熱体
- 11……Oリング
- 16……円筒状支持部
- 26……支持部
- 27……延在部
- 40……容器内空間
- W……半導体ウエハー

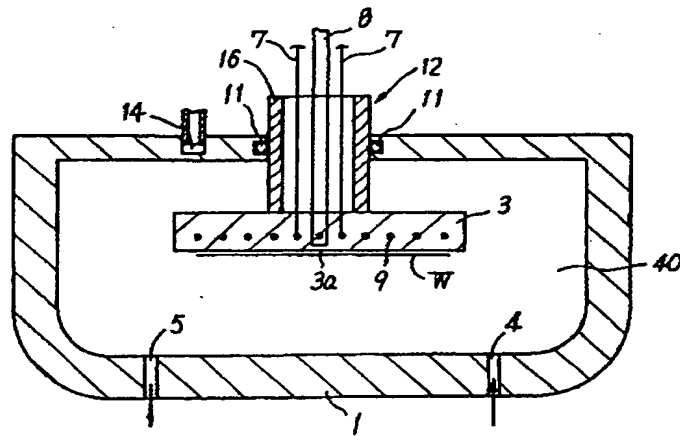
【第4図】



【第1図】



【第2図】



【第3図】

